

T22: Etching Technology for Nitride Semiconductors

窒化物半導体エッチング技術

～高制御性と低損傷性を求めて～

2019年 9月20日 (金)

13:30～17:35

北海道大学・札幌キャンパス
(E301教室)



窒化物半導体では、通常のウェットエッチングがそのまま適用しづらい特有の事情から、それに代わる様々なエッチング技術が提案されてきました。本シンポジウムでは、近年急速な進展を見せている「窒化物半導体エッチング技術」とそのデバイス応用、加工ダメージの評価について、第一線で活躍されている研究者を講師にお迎えし、最新の研究についてご紹介いただきます。

佐野泰久 (大阪大学)

触媒表面基準エッチング法によるGaN基板の無歪研磨

伊藤昌平 (オックスフォード・インストゥルメンツ)

Atomic Scale Processing for GaN Devices

堀切文正 (サイオクス)

GaN ウェットエッチング

三島友義 (法政大学)

PECエッチングによるメサ構造GaN p-n接合ダイオード

山田真嗣 (名古屋大学)

n型GaNのICP-RIEにおけるバイアスパワー制御による
プラズマダメージの低減

塩島謙次 (福井大学)

界面顕微光応答法によるエッチングしたGaN表面の2次元評価

菅原健太 (住友電気工業)

塩素中性粒子ビームエッチングによるGaN HEMT高信頼化

蔵口雅彦 (東芝研究開発センター)

リセスエッチング後のGaN表面処理

